BEST AVAILABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭64-88550

Int,Ci.⁴

.

識別記号 GCA 庁内整理番号 V-7204-2H 母公開 昭和64年(1989)4月3日

G 03 F 1/00 H 01 L 21/30 G C A 3 0 1 V - 7204 - 2H P - 7376 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②特 類 昭62-246654

母出 期 昭62(1987)9月30日

郊発明者太田

賢 司

大阪府大阪市阿倍針区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

60発明者 広兼

渚

司

伸

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

の発明者 伴

明

79発

和夫

理

順

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社

·

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社

内

の出 顋 人 シャープ株式会社

の代理人 弁理士原 謙三

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

1 L 2 HOS-4401-6

枝

1. 発明の名称

フォトマスク

2. 特許請求の範囲

1. 透光性のマスク基板にマスクパタンを形成 する遮光腹が設けられたフォトマスクにおいて、

上記遮光膜の表面に、遮光膜を被覆する透光性 の保護膜を設けたことを特徴とするフォトマスク。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、例えば、レーザ等の光にて情報の記録、再生および消去等を行う光メモリ素子の光露光方式による製造に供されるフォトマスクに関するものである。

(従来の技術)

この種の従来のフォトマスクは、第3図に示す ように、透光性のマスク基板11に、マスクパタ ンを形成する遮光性のエューCェーエ上等の金属 限12…が埋設されたもの、吸いは、第4図に示 すように、マスク茲板 1 1 の表面に金属膜 1 2 … が設けられたものに大別される。このようなフォトマスクを、例えば、光メモリの案内海の形成に使用する際には、その案内海の寸法が、一般に0.6~1.3 μ m というように、サブミクロンオーダーであることにより、マスクパタンを正確にレジストに転写するために、フォトマスクをレジストに密表させる密着転写が行われている。

(発明が解決しようとする問題点)

ところが、上記の密若転写の際には、フォトマスクへのレジストの付着、或いは、レジストとフォトマスクとの間へのごみの介入等により、しばしばフォトマスクに汚れが発生する。そして、汚れたフォトマスクは超音波洗浄されるが、この際に、金属膜12…の剝がれが生じ、マスクバタンの一部が欠損するという不認合を招来している。

(問題点を舒決するための手段)

本発明のフォトマスクは、上記の問題点を解決 するために、透光性のマスク基板にマスクパタン を形成する遮光限が設けられたフォトマスクにお いて、上記遮光膜の表面に、遮光膜を被覆する透 光性の保護膜を設けた構成である。

(作用)

上記の構成により、マスク基板に設けられた返 光度は保護膜にて保護される。これにより、選元 膜の剝がれが防止され、マスクパターンの欠損が 生じ難くなる。

(実施例1)

本発明の第1実施例を第1図に基づいて以下に 型明する。

本発明に係るフォトマスクは、石英、ソーダライム等からなる透光性のマスク基板1を有している。このマスク基板1の上部には遮光膜である複数の金属膜2 …が埋設されている。この金属膜2 …はマスクパタンを形成すると共に、マスク基板1に照射される紫外線等の露光用の光を遮断するようになっている。そして、金属膜2 … は、マスク なび1における金属膜2 …の配設部位をエッチングにて除去し、その部位に遮光性を有するTa、Ti、Cr或いはM。等の金属材料、または、

イム等のガラス材料からなるマスク基板1に会まれるS1O。成分との密着性が良好であり、特に独立な保護膜となる。そして英からなる金属膜2…にてスクルでなる金属膜2…をS1O。膜3を投資したでスクにて、光メモリ素子用窓内にないないには、数回の光メモリ素子の場合には、数回の光メモリ素子のはいて、マスクパタンの欠損が発生したのにおいてもパタン欠けが生じなかった。

また、本フォトマスクは、光磁気ディスク等の 光メモリ素子の製造に適する。即ち、光磁気ディ スクはメモリ媒体として、希土類元素と遷移金属 との合金薄膜を使用するのが一般的であるが、こ の合金薄膜は、水分や酸素等によって劣化し易い という性質を有している。そこで、本フォトマス クにより、光メモリ素子のガラス基板に案内海パ タンを露光して現像した後、エッチングにて直接 ガラス基板に案内操を関り込み、このガラス基板 これらの材料を母材とする、例えばTaS1、Mcs1等の材料が設けられこことによって形成されている。 尚、上記の金属版 2 …は、ネが型レジストを用いる場合には、現像によってレジストが 除去される部位に設けられ、ポジ型レジストを用いる場合には、現像にてレジストが残る部位に設けられる。

上記のマスク基板1および金属膜2…上には、保護膜である透光性のS1〇。膜3が設けられている。このS1〇。膜3の膜厚は、30~300mm程度が望ましい。即ち、S1〇。膜3は弾くなり過ぎると、金属膜2…に対する保護機能が低下する反面、厚くなり過ぎるとパタン転写の構度が低下する。

上記の構成において、木フェトマスクでは、SiO.膜3にて金属膜2…が被覆されていることにより、たとえば、超音波洗浄の際においても、金属膜2…の剝がれが防止され、マスクパタンが保護されている。

また、SIO。膜3は、石英、或いはソーダラ

上に、希土類元素と逐移金属との合金薄膜を形成すると、ガラス基板を通じてメモリ螺体に達する 酸素や水分がないため、非常に信頼性の高いメモ リ素子を得ることができる。

尚、本実施例では、保護膜としてSIO。膜3を設けた例を示したが、これに限定されるものではなく、保護機能を有する透光性の膜であれば、他の保護膜であっても構わないのは勿論である。その材料としては、例えば、A&N、SIN、TaN等の窒化物、或いはA&2O1、TIO2等の酸化物が挙げられる。

また、金属膜 2 は、前記した金属の単層膜、金属とその金属の酸化物との二層膜、或いは三層以上の復層膜としてもよい。さらに、遮光膜としては、金属膜 2 に限定されるものではなく、遮光性を有し、かつマスクパタンを形成し得る他の材料からなるものであってもよい。

(実施例2)

本発明の第2実施例を第2図に基づいて以下に 説明する。尚、前記第1実施例と同一の概能を有 する部材には同一の符号を付記し、その説明を省略してある。

)

石英、ソーダライム等のガラス板、或いはアクリル、エポキシ等のプラスチック板からなる選光性のマスク基板1上には、遮光膜である金属膜2…になってスクパタンが形成されている。これの多板1上および金属膜2…の表面の凸状には立った。 保護膜であるSiO。膜3が凹凸状に設ってれている。このSiO。膜3は上に会にしている。このよりも厚くすることが望ました一枚ご膜2・の厚めより、SiO。膜3が連続した一枚ご膜かできる。

上記のような構成では、金属膜 2 … がマスク基板 1 に埋設されていないので、金属膜 2 … の形成工程を簡素化することができる。その反面、 S i O 。膜 3 は、金属膜 2 … の確実な保護を行うために、上記の如く寸法上に若干の制限を受けることになる。

1 はマスク基板、 2 は金属膜 (遮光膜) 、 3 は S i O : 膜 (保護膜) である。

> 特許出職人 シャープ 株式会社 代理人 弁理士 原 雄 事気弁弁

(発明の効果)

本発明のフェトマスクは、以上のように、選先性のマスク基版にマスクパタンを形成する選光膜が設けられたフェトマスクにおいて、上記選光膜の表面に、選光膜を被関する透光性の保護膜を設けた構成である。

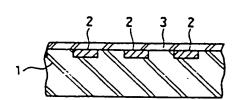
それゆえ、マスク基板に設けられた遮光膜は保護にて保護され、遮光膜の朝陰による欠損が防止される。これにより、寿命を長くすることができる。即ち、従来のフォトマスクでは、数回の指光工程によりパタンの欠損を生じて使用不能となり、量産に不適当であったのに対し、本フォトで、カクでは、マスクパタン欠損の発生類度が致折し、対ラス基板型光磁気ディスクの量産が容易になるという効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

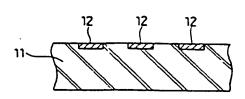
第1図は本発明の一実施例を示す要部の経断面図、第2図は本発明の他の実施例を示す要部の経 断面図、第3図は従来例を示す要部の経断面図、 第4図は他の従来例を示す要部の経断面図である。

時間昭64-88550(4)

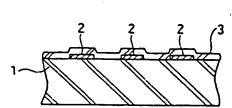




彩 3 図



第 2 图



郑 4 🗵

